

주요 사양

(달리 명시되지 않는 한, $T_c=25^\circ\text{C}$)

부품 번호		GT30J65MRB	
패키지		TO-3P(N)	
절댓값	컬렉터-에미터 전압 V_{CES} (V)		650
최솟값	컬렉터 전류(DC) I_c (A)	$T_c=25^\circ\text{C}$	60
		$T_c=100^\circ\text{C}$	30
평가	접합 온도 T_j ($^\circ\text{C}$)		175
컬렉터-에미터 포화 전압 $V_{CE(sat)}$ typ. (V)		$I_c = 30\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_c=25^\circ\text{C}$	1.40
스위칭 시간(하강 시간) t_f typ. (ns)		유도성 부하, $V_{CE}=400\text{V}, I_c=15\text{A},$ $V_{GE}=15\text{V}, R_g=56\Omega, T_c=25^\circ\text{C}$	40
스위칭 손실(턴오프 스위칭 손실) E_{off} typ. (mJ)		유도성 부하, $V_{CE}=400\text{V}, I_c=15\text{A},$ $V_{GE}=15\text{V}, R_g=56\Omega, T_c=175^\circ\text{C}$	0.35
다이오드 순전압 V_f typ. (V)		$I_f=15\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_c=25^\circ\text{C}$	1.20
접합-케이스 열 저항 $R_{th(j-c)}$ max($^\circ\text{C}/\text{W}$)			0.75
샘플 확인 및 제공 여부			온라인 구매